

D20LC40**400V 20A****特長**

- 低ノイズ
- trr=50ns
- フルモールド

Feature

- Low Noise
- trr=50ns
- Full Molded

用途

- スイッチング電源
- フライホール
- 家電、OA
- FA

Main Use

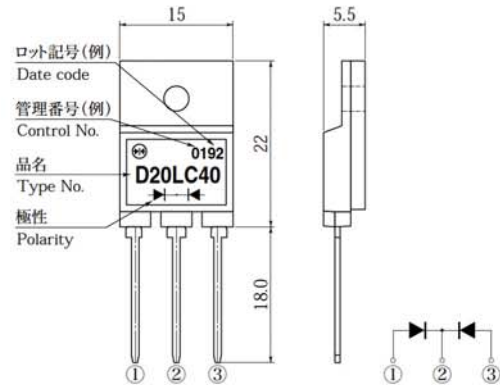
- Switching Regulator
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation
- Factory Automation

■外観図 OUTLINE

Package : ITO-3P

Unit:mm

Weight 4.3g (Typ)



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)**

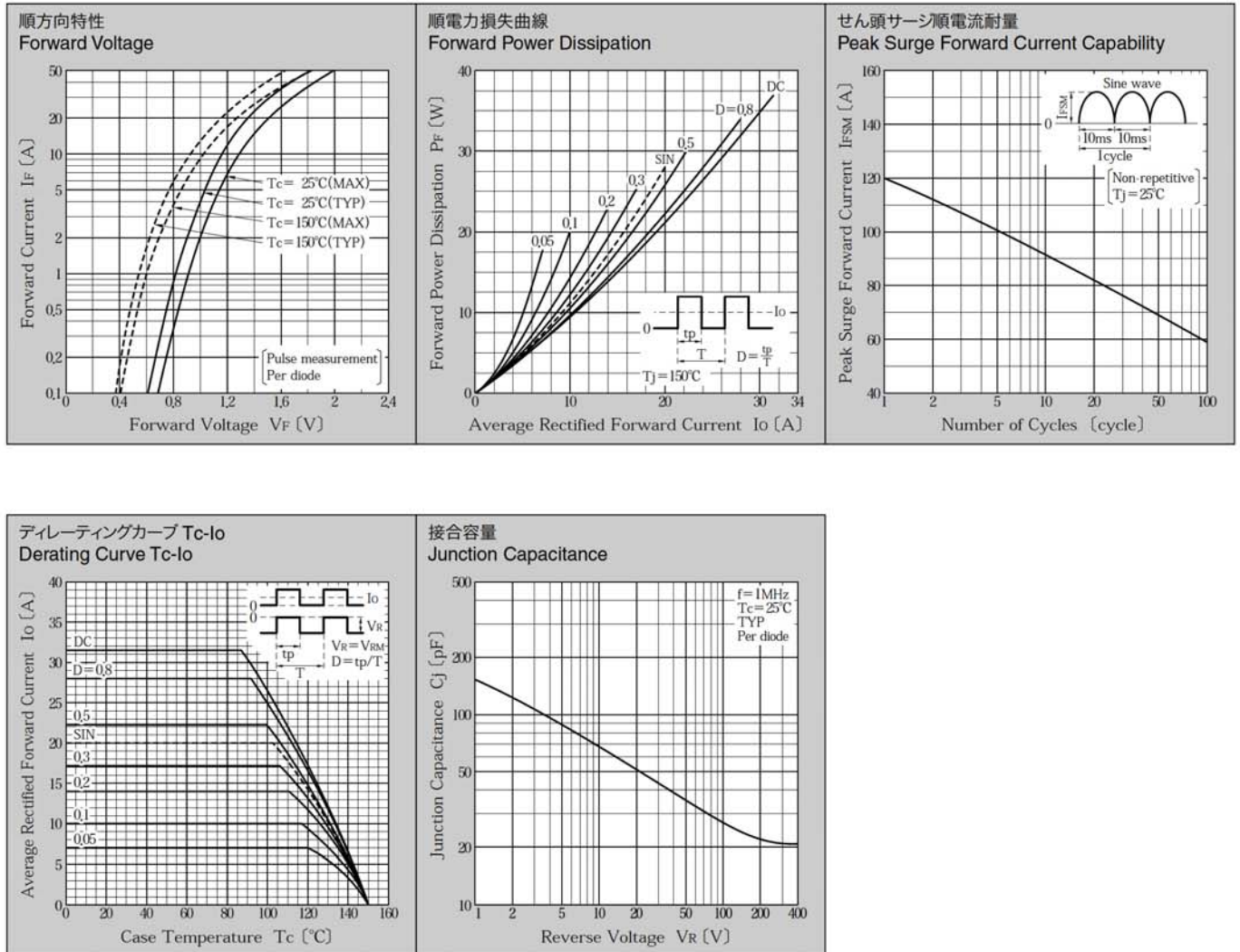
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D20LC40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, フィン付き, 1素子当りの出力電流平均値 I _o /2, T _c = 102°C 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, Per diode I _o /2, T _c = 102°C		20	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		120	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute		1.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5N·m) (Recommended torque: 0.5N·m)		0.8	N·m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 10 A,	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} ,	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5 A, I _R = 1.0 A,	1素子当りの規格値 Per diode	MAX 50	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 1.7	°C/W

Center Tap Common Cathode

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 * Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 * Typical is a statistical average of the device's ability.